

ポリマーラッピング法を用いた半導体型 単層カーボンナノチューブの直径選択分離

SATテクノロジー・ショーケース2025

■ はじめに

単層カーボンナノチューブ(SWCNT)には、構造により 異なる電気的性質(金属型・半導体型)をもった2種類が存 在し、それらが混合して合成されるという大きな問題があっ た。近年の分離技術の進展により、現在では密度勾配遠 心分離法、電界誘起層形成法、ゲル分離法、ポリマーラッ ピング法など様々な手法によって、金属型・半導体型の SWCNTの分離精製が可能となっている。これらの分離法 の中で、ポリマーラッピング法は、高純度の半導体型の SWCNT(s-SWCNT)を分離するのに有効な技術である。

ポリマーラッピング法に用いられる代表的なポリマーとし て、ポリフルオレン (PFO:poly(9,9-dioctyfluorenyl-2,7-diyl)) (図1(a))がある。PFOを用いることにより、高純度のs-SWCNTを分離できることが報告されている¹⁾。しかしなが ら、PFOを用いた場合、1.1 nm以下の直径の小さいs-SWCNTしか分離できない。直径の小さいs-SWCNTは、電 極との間にショットキー障壁を生じるため、デバイス応用の 際に性能が低下する原因となるといった問題がある。これ まで、デバイス応用に適した大径(>1.2 nm)のs-SWCNTを 分離可能なポリフルオレン系ポリマーの研究が行われて いる²⁾。しかしながら、大径のs-SWCNTを分離可能なポリ マーは、数が少ないのが現状である。そこで本研究では、 大径のs-SWCNT分離にこれまで用いられたことのないフ ルオレン系ポリマーであるPFO=A (poly[(9,9-dioctyl-2,7divinylenefluorenylene)-alt-co-(9,10-anthracene)]) (図1(b)) により、s-SWCNTの分離を試みた。

SWCNTには、CVD法の一種であるeDIPS法3) により合 成されたものを用いた。eDIPS法は、高結晶・高純度・高収 率かつ低コストでSWCNTを製造可能な手法である。

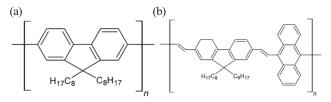


図1 ポリマーの構造式 (a) PFO, (b) PFO=A

■ 活動内容

代表発表者

本実験では、以下の手順でポリマーラッピング分離を行 った。まず、eDIPS法で合成した平均直径1.3 nmの SWCNTとPFOあるいはPFO=Aをトルエン溶媒中に加えた

後、超音波ホモジナイザーにより分散した。遠心分離後、 上澄みを回収した。回収した上澄み液の光吸収スペクトル を測定した。

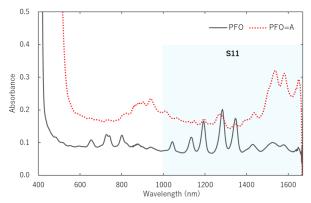


図2 PFOおよびPFO=Aを用いて分離した s-SWCNT分散液の光吸収スペクトル

PFOおよびPFO=Aを用いて分離した際の光吸収スペク トルを図2に示す。波長が1000 nm以上の領域において、s-SWCNTの光学遷移Suに対応するピークが見られた。そ のピーク位置は直径に依存し、直径が大きいほど高波長 側に観測される。2つのスペクトルを比較すると、Suピーク の位置が異なり、PFO=Aを用いて分離した場合の方が、 高波長側にS₁₁ピークが観測された。従って、PFO=Aを用 いた方が、より大径(>1.2 nm)のs-SWCNTを含む分散液を 得られることが新たにわかった。本結果はデバイス応用に つながる第一歩である考えられる。

■ 今後の展開

現在、得られたs-SWCNTの蛍光分光測定に着手してい る。その結果を解析し、構造(カイラリティ)の評価を行う。ま た、分離メカニズム解明の指針を得るため、PFOおよび PFO=Aとs-SWCNTの相互作用を分子動力学シミュレーシ ョンにより調べる。

■ 参考文献

- J. Wang. et al., Nanoscale, (2022), 14, 1096-1106 1)
- 2) Y. Li, et al., Adv. Funct. Mater, (2021), 32, 2107119
- 3) T. Saito, et al., Journal of Nanoscience and Nanotechnology, (2008), 8, 6153-6157

種平 立輝(たねひら りつき) 兵庫県立大学大学院 工学研究科 産業技術総合研究所ナノ材料研究部門

問合せ先 〒671-2280 兵庫県姫路市書写 2167

E-mail: anriutmpacjoiermo123@gmail.com

■キーワード: (1)単層カーボンナノチューブ (2)ポリマーラッピング分離

(3) 半導体

■共同研究者:藤井俊治郎(兵庫県立大学) 菜原有紀(産業技術総合研究所)

斎藤毅(産業技術総合研究所)